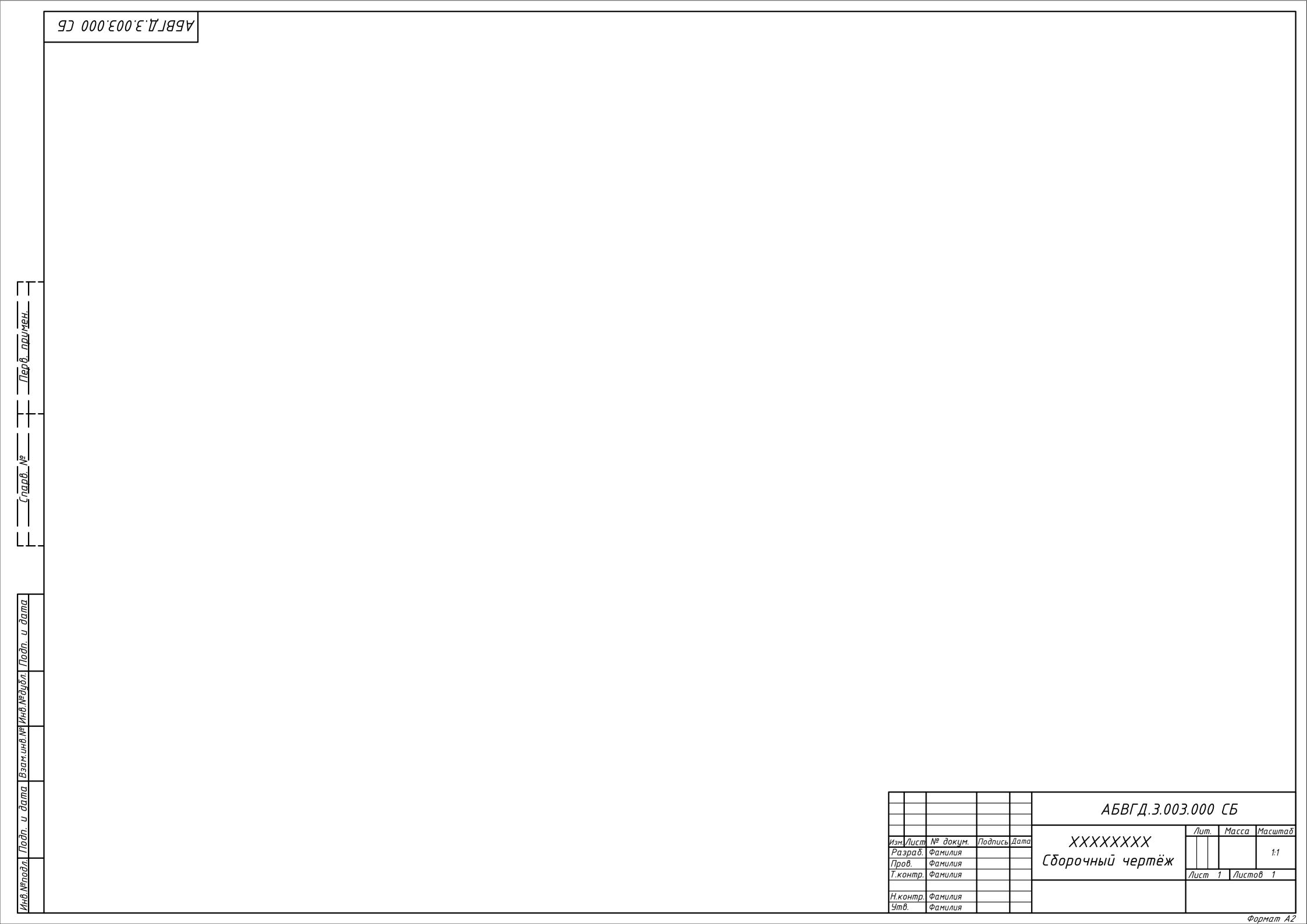
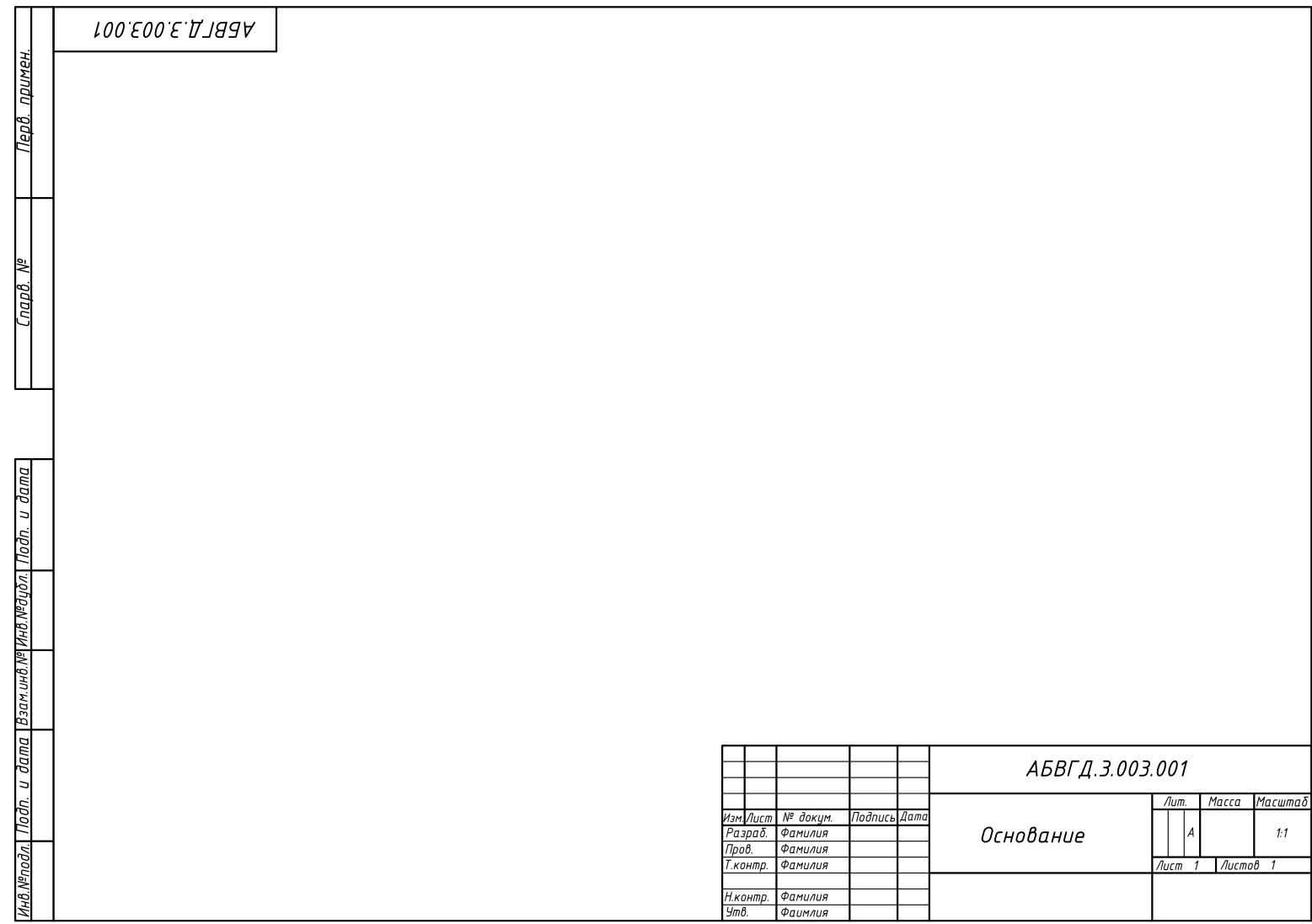
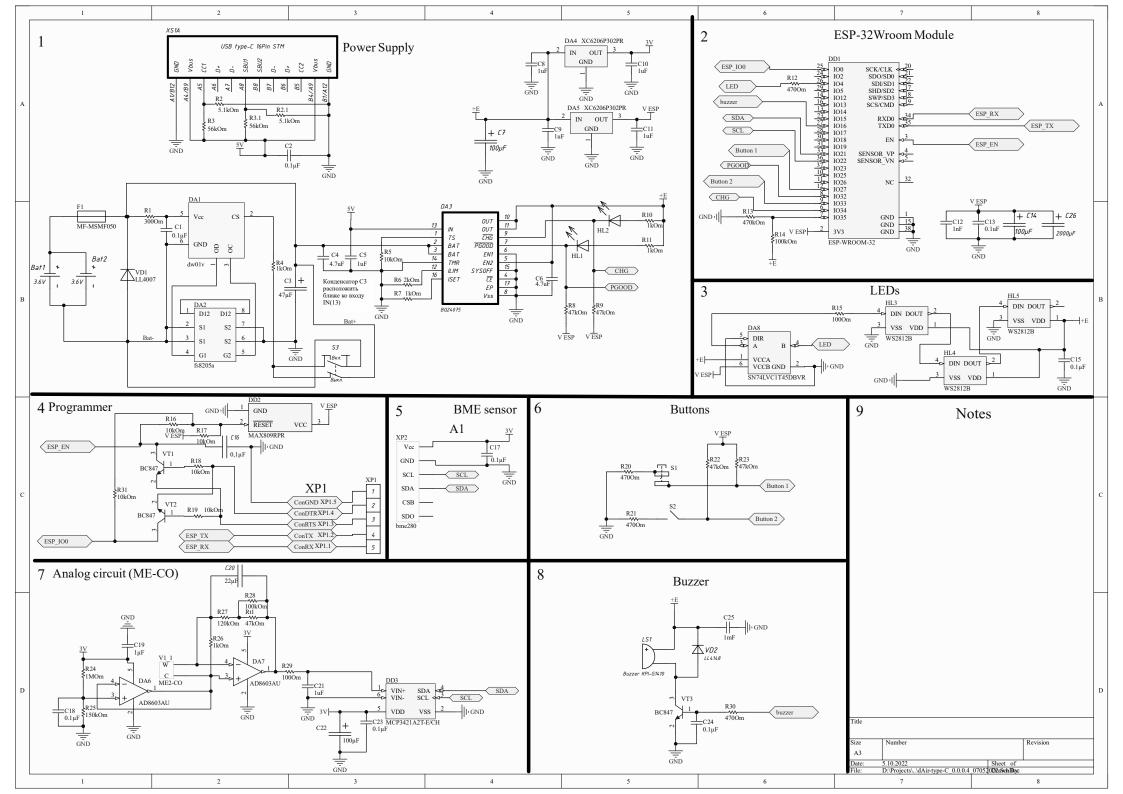
Ĥ.		Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование 🖇 Приме-	
Терв. примен.	ŀ					<u>Документация</u>	
Пер	ļ	A3			АБВГД.3.003.000 СБ	Сборочный чертёж	
H	_	A2			АБВГД.3.003.000 ЭЗ	Схема электрическая	
	ŀ	\dashv	\dashv			принципиальная	
Cnapβ. Nº	1	A 4			АБВГД.3.003.000 ПЭ	Перечень элементов	
Спар		A 4			TY BY 000000000.003-2021-7	ГУ Технические условия	
		A 4			АБВГД.3.003.000 РЭ	Руководство по эксплуатации	
						<u>Сборочные единицы</u>	
	_[
дата	ļ	A2		1	АБВГД.3.003.101 СБ	Плата	
Подп. и	ļ					<u>Детали</u>	
	\dashv	A 3		2	<i>АБВГД.3.003.001</i>	Основание 1	
δήρ	ŀ	A 3		3	АБВГД.3.003.002	Крышка 1	
Инв.Л							
3.№	╡						
Взам.инв.№ Инв.№дубл.							
$\overline{}$					<u>i</u> -	<u> </u>	
Подп. и дата		14	7	A	We down Hodous Jama	АБВГД.3.003.000	
Инв.№подл. По	-	Изм. Лист № докум. Подпись Дата Разраб. Фамилия Пров. Фамилия Т.контр. Фамилия Н.контр. Фамилия Утт. контр. Фамилия					

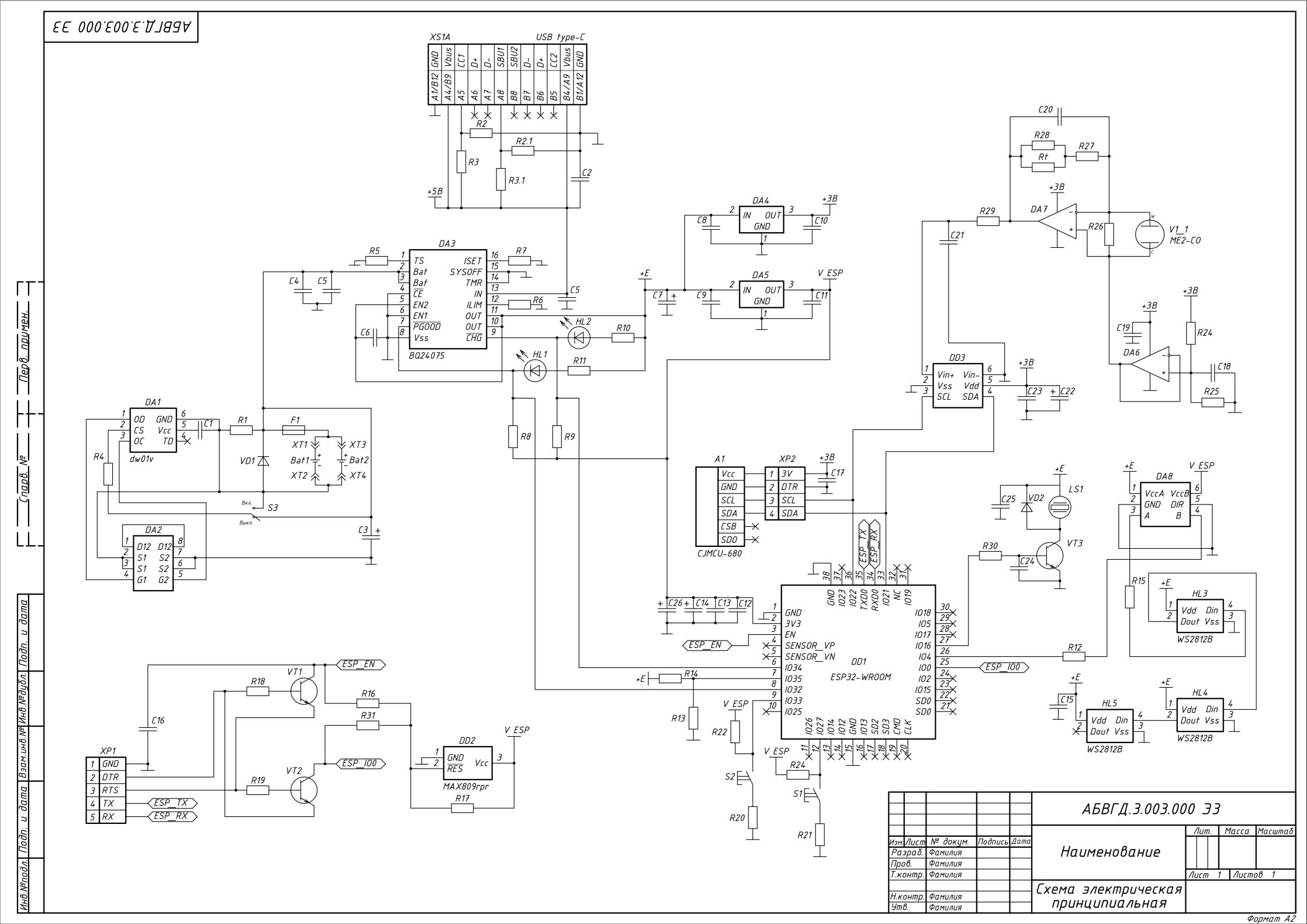
7:	формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание	
Перв. примен.					Стандартные изделия			
Перв			4		Винт M2×5	4		
\parallel								
$ar{o} \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \! \!$								
Cnapb. Nº								
ата								
อдп. и с								
дубл. П								
Vº N+β.Nº								
Взам.инв.№ Инв.№дубл. Подп. и д								
Подп. и дата								
Инв.№подл.			<u></u>				Стр.	
Хоруровал АБВГД.3.003.000 Коруровал АБВГД.3.003.000								





	Z00.E00.E.D.183A	
Перв. примен.		
Ĺnapβ. №		
Инв.№подл. Подп. и дата Взам.инв.№ Инв.№дудл. Подп. и дата		
и дата		АБВГД.3.003.002
подл. Подп.		Изм. Лист № докум. Подпись Дата Разраб. Фамилия Крышка Крышка Лит. Масса Масштаб Пров. Фамилия Лист 1 Листов 1
Инв. №		Н.контр. Фамилия Утв. Фаимлия





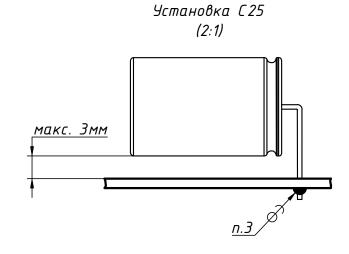
	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание	
<u>Перв. при</u> мен.		Сборочные единицы			
) da	A 1	Модуль СЈМСИ-680 (ВМЕ680)			
96.					
<u>Net</u>		Микросхемы			
	DA1	Контроллер заряда АКБ DW01V	1	S0T23-6	
-	DA2	Транзисторная сборка FS8205A, 2-mosfet N-channel	1	TSSOP-8	
	DA3	Контроллер заряда Li-ion AKБ BQ24075RGT	1	VQFN-16	
	DA4,DA5	LDO регулятор напряжения XC6206P302PR 3B, 0.2A	2	S0T89-3	
<u>%</u> .	DA6,DA7	Операционный усилитель AD8603AU, rail-to-rail	2	TS0T-5	
<u> Cnapô.</u> N <u>º</u>	DA8	Преобразователь уровня SN74LVC1T45DBVR	1	S0T23-6	
<u> [</u> 2]	DD1	Микроконтроллер ESP32-WROOM 38-pin	1		
	DD2	Супервизор MAX809RPR 2.62B	1	SOT-23	
İİ	DD3	АЦП MCP3421A2T-E/CH, 2.7-5.5B, 18 δит	1	S0T23-6	
L <u>L</u> _					
		Резисторы			
	R1	Резистор 3000м±5% smd 0805	1		
ата	R2,R2.1	Резистор 5,1к0м±5% smd 0805	2		
10	R3,R3.1	Резистор 56кОм±5% smd 0805	2		
ח. ת	R4,R7	Резистор 1к0м±5% smd 0805	2		
Подп.	R5	Резистор 10кОм±5% smd 0805	1		
	R6	Резистор 2кОм±5% smd 0805	1		
<u>/</u> ē∂y	R8,R9	Резистор 47кОм±5% smd 0805	2		
1нв./	R10,R11	Резистор 1кОм±5% smd 0805	2		
Λο̄Ν	R12	Резистор 4700м±5% smd 0805	1		
Взам.инв.№ Инв.№дубл. 	R13	Резистор 470кОм±5% smd 0805	1		
зам.					
\vdash	-		Τ-		
дата					
n o					
Подп.	Изм. Лист 1	№ докум. Подпись Дата	.000 ПЭ		
дл.	Разраδ. Ф	Рамилия	/	Лит. Лист Листов	
Инв.№подл.	Н.контр. Ф	Рамилия Рамилия Рамилия Перечень Элементо	B	1 1 3	
Z	Утв. Ф	Рамилия Копировал		Φορμαπ ΔΔ	

ΓΤ΄ <u>.</u>	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Перв. примен</u>	R14	Резистор 100кОм±5% smd 0805	1	
<u> </u>	R15	Резистор 1000м±5% smd 0805	1	
<u> </u>	R16-R19	Резистор 10кОм±5% smd 0805	4	
Пе	R20,R21	Резистор 4700м±5% smd 0805	2	
	R22,R23	Резистор 47кОм±5% smd 0805	2	
-	R24	Резистор 1MOм±5% smd 0805	1	
1 1	R25	Резистор 150кОм±5% smd 0805	1	
	R26	Резистор 1кОм±5% smd 0805	1	
<u>∛ </u> 	R27	Резистор 120кОм±5% smd 0805	1	
<u> </u>	R28	Резистор 100кОм±5% smd 0805	1	
	R29	Резистор 1000м±5% smd 0805	1	
	R30	Резистор 4700м±5% smd 0805	1	
ii	R31	Резистор 10кОм±5% smd 0805	1	
	R†	Резистор 47кОм±5% smd 0805	1	
		Конденсаторы		
дата	C1,C2	Керам. чип конденсатор 0,1мкФ±10% – 16B smd 0805	2	X5R или X7R
1 1	<i>C3</i>	Конденсатор танталовый 47мкФ±10% – 10В тип В	1	
n. u	C4,C6	Керам. чип конденсатор 4,7мкФ±10% – 16B smd 0805	2	X5R или X7R
Подп	<i>C5</i>	Керам. чип конденсатор 1мкФ±10% – 16B smd 0805	1	X5R или X7R
	<i>C</i> 7	Конденсатор танталовый 100мкФ±10% – 16B тип В	1	
Взам.инв.№ Инв.№дубл. 	C8-C11	Керам. чип конденсатор 1мкФ±10% – 16B smd 0805	4	X5R или X7R
1нв./	C 12	Керам. чип конденсатор 1нФ±10% – 10B smd 0805	1	X5R или X7R
√ōN	C 13	Керам. чип конденсатор 0,1мкФ±10% – 16B smd 0805	1	X5R unu X7R
инв.	C 14	Конденсатор танталовый 100мкФ±10% – 16B тип В	1	
зам.	C 15	Керам. чип конденсатор 0,1мкФ±10% – 16B smd 0805	1	X5R или X7R
-	C 16	Керам. чип конденсатор 0,1мкФ±10% – 10B smd 0805	1	X5R или X7R
дата	C 17, C 18	Керам. чип конденсатор 0,1мкФ±10% – 16B smd 0805	2	X5R uли X7R
n o	C 19	Керам. чип конденсатор 1мкФ±10% – 10B smd 0805	1	X5R uли X7R
Подп.	C20	Керам. чип конденсатор 22мкФ±10% – 10B smd 0805	1	X5R или X7R
оди				
Инв.№подл.	Изм. Лист 1	Дата АБВГД.3.003.0 № докум. Подпись Дата	00	ПЭ Стр.

	Поз. обозна- чение	Наименование	Кол.	Примечание
<u>Перв. при</u> мен.	C 21	Керам. чип конденсатор 1мкФ±10% – 16B smd 0805	1	X5R или X7R
<u>ndu</u>	C 22	Конденсатор танталовый 100мкФ±10% – 16B тип В	1	
<u> </u>	C23,C24	Керам. чип конденсатор 0,1мкФ±10% – 16B smd 0805	2	X5R uли X7R
Пе	C 25	Керам. чип конденсатор 1мФ±10% – 10B smd 0805	1	X5R uли X7R
	C 26	Конденсатор электролит. 2000мкФ±10% – 10В	1	Ф13×20×5мм
 -				
1 1		Транзисторы		
	VT1-VT3	Транзистор ВС847С	3	NPN, SOT-23
<u> </u>				
арв		Диоды		
	VD1	Диод выпрямительный LL4007	1	MELF/ DO-213AB
	VD2	Диод выпрямительный LL4148	1	miniMELF/ SOD-80
11	HL1,HL2	Светодиод GNL-1206SRC SMD	2	
	HL3-HL5	RGB cвemoduod WS2812B	3	
		Разъёмы и держатели		
дата	XP1	Линейка штыревая PLS-5 (DS1021-1×5)	1	5 конт., шаг 2.54мм
u de	XP2	Линейка штыревая PLS-4 (DS1021-1×4)	1	4 конт., шаг 2.54мм
	XS1A	Разъём USB Туре-C-31-M-12	1	
Подп.	XT1-XT4	Держатель АКБ 18650 KEYS54 (KLS5-54T)	4	
δи.				
Взам.инв.№ Инв.№дубл. 		Прочее		
1нв.	LS1	Зуммер пьезоэлектрический КРІ-G1410	1	
ōN:	F1	Предохранитель самовосст. MF-MSMF075, 0.75A	1	SMD 1812
. инв	V <u>1_</u> 1	Газовый сенсор МЕ2-СО	1	
зам	Bat1,Bat2	Li-ion AK5 NCR18650, 3200mAH	2	
\vdash	S1	Кнопка тактовая KLS-TS6604-7.0 или IT1102WB	1	прямая, h=7мм, SMD
дата	<i>S2</i>	Кнопка тактовая KLS-TS6606-8.0 или IT1102HC, или	1	угловая, h=8мм
n n		TS-A3PV, или TC-0206, или IT-1102NC		
Подп.	S3	Кнопочный переключатель 58LHTHRA	1	
\vdash	-			
поди				
Инв.Nºподл.	Изм. Лист Л	Де докум. Подпись Дата АБВГД.З.003.0	00	ПЭ — Стр.

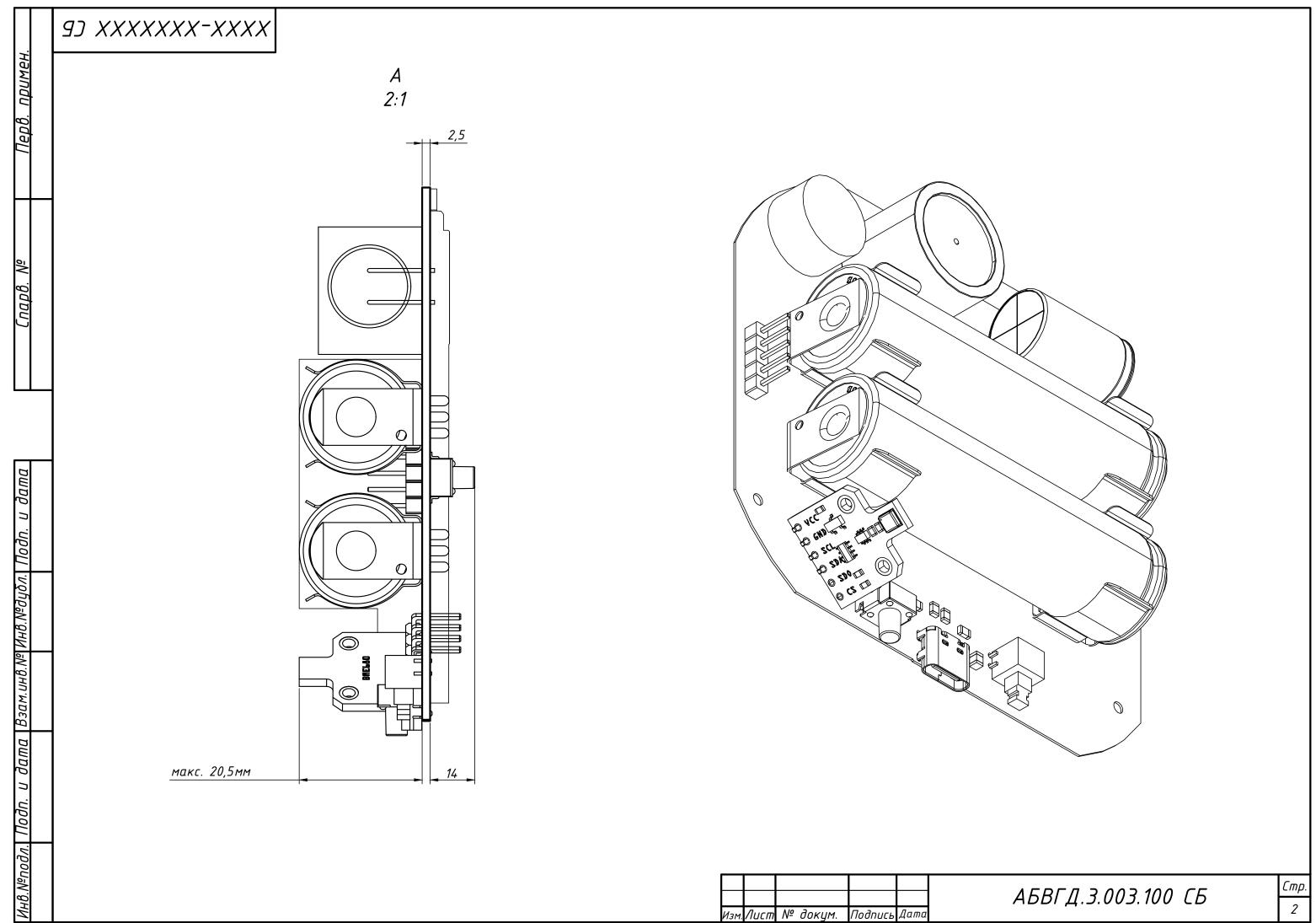
Установка R1-R31, Rt, C1-C25 (5:1)





- 1. Размеры для справок.
- 2. Монтаж РЭ вести согласно чертежа, ГОСТ 29137.
- 3. Пайку выводов ЭРЭ производить припоем ТЗА ПОС-61М ГОСТ 21931.
- 4. Маркировка держателелей АКБ XT1-XT4 показана условно.
- 5. Монтаж на плату элементов поз. 48-51 производить после промывки и просушки печатного узла.
- 5. Высота выступающих концов выводов должна быть в пределах от 2 до 2,5мм.
- 6. Запрограммировать устройство через программатор хххххххх, подклюив к разъёму XP1, файлом прошивки "хххххххххх" программы микроконтроллера XXXX.XXXX.
- 7. Маркировать порядковый заводской номер печатного узла и год изготовления.
- 8. Клеймить знак ОТК.
- 9. После сборки и регулировки печатный узел со стороны элемента DD1 покрыть лаком УР-231 бесцветным. Элементы HL3,HL4,HL5, S1 от покрытия предохранить.

				АБВГД.3.003.100 СБ							
					Лип	7.	Масса	Μαсштαδ			
Изм. Лис	т № докум.	Подпись	Дата	XXXXXXXX							
Разрад	б. Фамилия	Фамилия Фамилия		Сборочный чертёж		<i>A</i>		1:1			
Προβ.	Фамилия										
Т.конт,	о. Фамилия				Лист 1		Листо	β 2			
Н.конт,	р. Фамилия										
Утв.	Фаимлия										



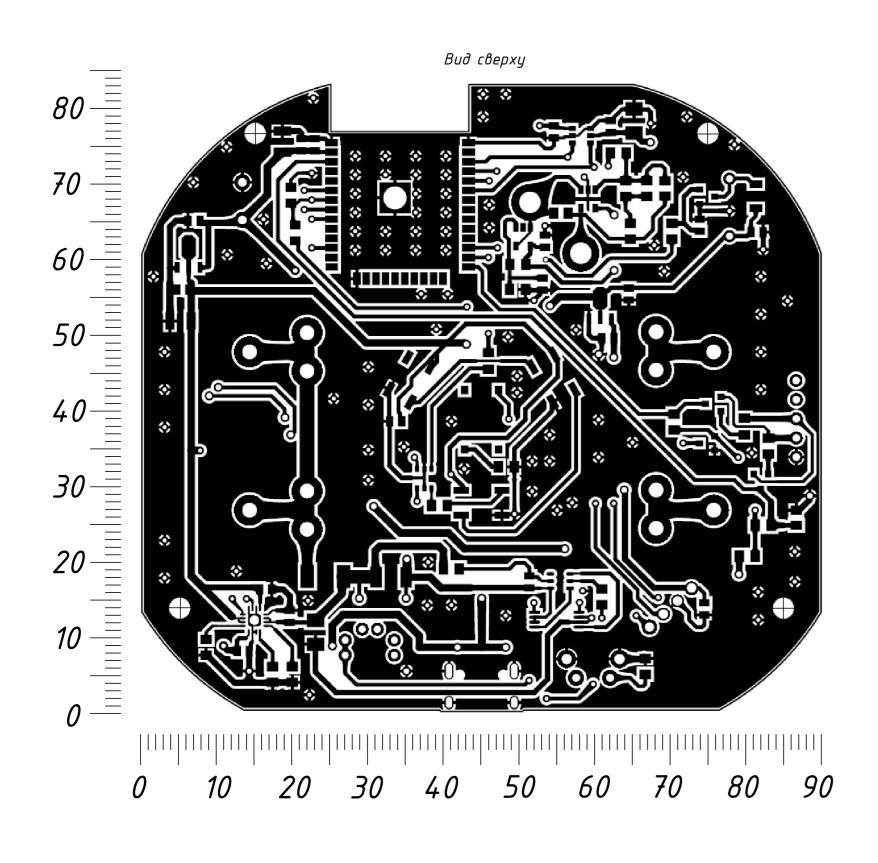
ЭН.	Формат	Зона	Поз.	Обозначе	ние	Наименова	ние	Кол.	Приме- чание
Терв. примен.						<u>Документация</u>			
Перв	A 3			АБВГД.3.003.100 СБ		Сборочный чертёж			
	/			АБВГД.0.000.000		Исходный текст			-) DVD-R
	Α4			АБВГД.0.000.000		Исходный текст			Размножить по особому указанию
ο̄Ν	*/			АБВГД.0.000.000		Программа микроконп	проллера		-*) DVD-R
<u>Cnap8. Nº</u>	Α4			АБВГД.0.000.000		Программа микроконп	проллера		Размножить по особому указанию
Ú	*/			АБВГД.0.000.000		Файл данных платы			-*)
	Α4			АБВГД.0.000.000		Файл данных платы			Размножить по особому указанию
						<u>Детали</u>			
ата	A 3		1	АБВГД.3.003.101		Плата печатная		1	
л и д		\dashv				Прочие издели	IЯ		
Поді			2			Зуммер КРІ-G1410		1	LS1
јди.	_		3			Предохранитель MF-MSMF075			F1
.Nº∂ı			4			Газовый сенсор МЕ2-	<i>CO</i>	1	V <u>1_</u> 1
Инв	┢	\vdash	5			CJMCU-680 (BME680)		1 2	A1
эΝ.θн.			6			Li-ion AKB NCR18650			Bat1,BAt2
Взам.инв.№ Инв.№дубл. Подп.					ГΤ.				
					<u> </u>				
Подп. и дата	Изм	. /Iu	cm /	№ докум. Подпись Дата		<i>АБВГД.3.00</i> <u>3</u>	3.100		
Инв.№подл. П	Ра Пр Т.к	зра ов. онт	δ. Φ φρ. Φ ηρ. Φ	Рамилия Рамилия Рамилия Рамилия	Устро	ойство хххххх Плата	/lum	Лист 1	Листов 4

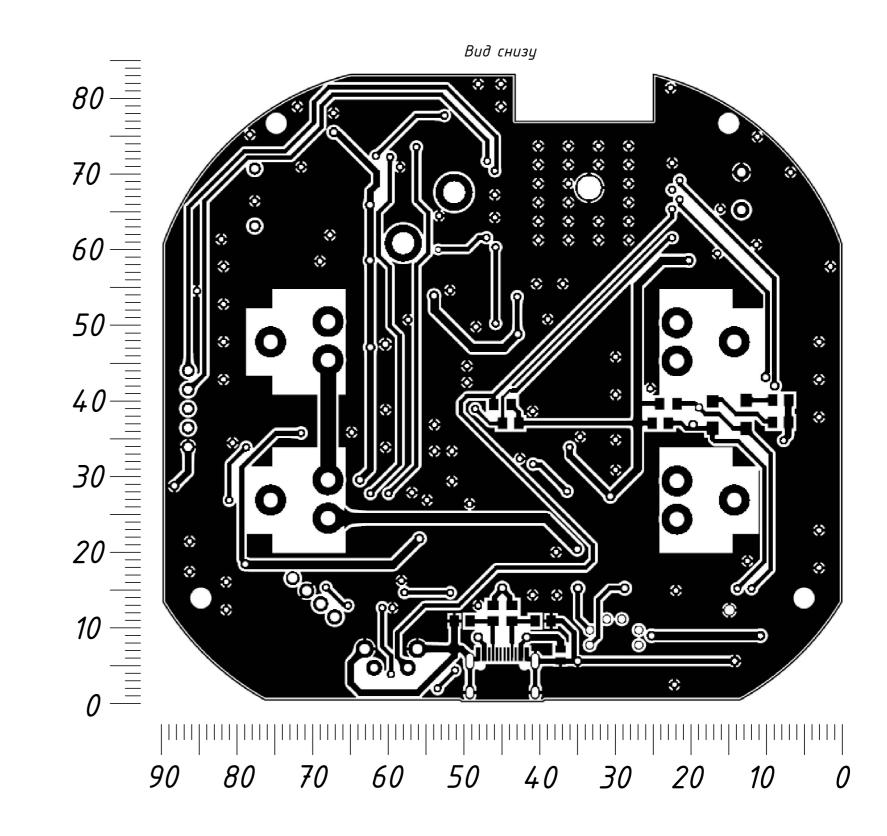
Ĥ.	Формат	Зона	Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание
Перв. примен.			7		W. C. T.C.(201 7.2		64
	\vdash		7		Кнопка KLS-TS6604-7.0	1	<i>S1</i>
<u>2ρβ.</u>	\vdash				или IT1102WB	+	
	\vdash		8		Кнопка KLS-TS6606-8.0	1	52
	<u> </u>				или IT1102HC, или TS-A3PV,		
H	╄				или TC-0206, или IT-1102NC	<u> </u>	
	\vdash		9		Кнопочный переключатель	1	
Qi					58LHTHRA		<i>S3</i>
Cnapb. Nº			+				
Cnat					Микросхемы		
			10		DW01V	1	DA1
			11		FS8205A	1	DA2
	╁		12		BQ24075RGT	1	DA3
			13		XC6206P302PR	2	DA4,DA5
			14		AD8603AU	2	DA6,DA7
дата			15		SN74LVC1T45DBVR	1	DA8
			16		ESP32-WROOM 38-pin	1	DD1
n. u			17		MAX809RPR	1	DD2
Подп.			18		MCP3421A2T-E/CH	1	D3
убл.	brack						
Взам.инв.№ Инв.№дубл.	\vdash				Резисторы		
<i>'N</i> <i>ō</i> ∧	╀		19		3000m±5% smd 0805	1	R1
1нв./			20		5,1κOm±5% smd 0805	2	R2,R2.1
зам.			21		56κOm±5% smd 0805	2	R3,R3.1
	╀		22		1ĸOm±5% smd 0805	5	R4,R7,R10, R11,R26
ата			23		10ĸ0m±5% smd 0805	6	R5,R16-R19 R31
u d			24		2ĸOm±5% smd 0805	1	R6
Подп. и дата			25		47ĸOm±5% smd 0805	5	R8,R9,R22, R23,Rt
			26		4700m±5% smd 0805	4	R12,R20,R21, R30
Инв.№подл.	Изм	ı. /lu	cm № c	докум. Подпись Дата Корило	АБВГД.З.003.100		Стр.

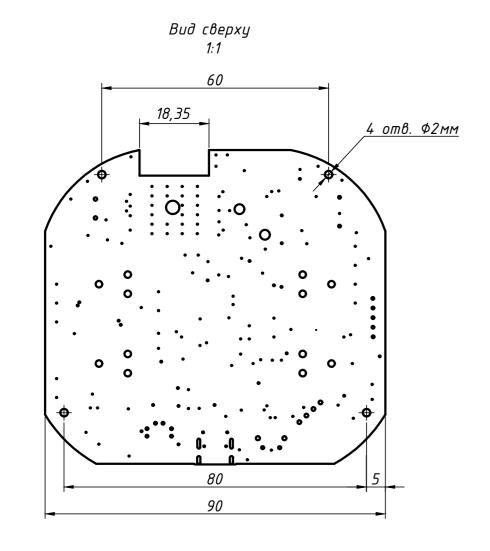
7:	Формат	Зона	Поз.	Оδозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание		
Перв. примен.									
Ìdu			27		470κOm±5% smd 0805	1	R13		
<i>D</i> θ.			28		100κOm±5% smd 0805	2	R14,R28		
<u>lle</u>			29		1000м±5% smd 0805	2	R15,R29		
			30		1MOm±5% smd 0805	1	R24		
	┺		31		150κ0m±5% smd 0805	1	R25		
			32		20κ0m±5% smd 0805	1	R27		
ō∧									
Cnapв. Nº	\vdash		\vdash		Конденсаторы		C17,C18,C23,C24		
Cna			33		0,1mκΦ±10%-16B smd 0805 X7R	8	C1,C2,C13,C15		
			34		0,1mκΦ±10%-10B smd 0805 X7R	1	C 16		
			35		47mκΦ±10%-10B mun B	1	С3		
	╅		36		4,7mkΦ±10%-16B smd 0805 X7R	2	C4,C6		
			37		1mκΦ±10%-16B smd 0805 X7R	7	C5,C8-C11, C19,C21		
			38		100mκΦ±10%-16B mun B	3	C7,C14,C22		
ата			39		1нΦ±10%-10B smd 0805 X7R	1	C 12		
1.01			40		22mκΦ±10%-10B smd 0805 X7R	1	C 20		
n. u			41		1mΦ±10% - 10B smd 0805 X7R	1	C 25		
Подп.			42		К50-35-10В-2000мкФ 13×20мм	1	C 26		
<i>1</i> δ <i>n</i> .	ho								
νe∂ι					Транзисторы				
Инв.			43		BC847C	3	VT1-VT3		
<i>•</i> Ν·Ν <i>•</i>									
Взам.инв.№ Инв.№дубл.		H			Диоды				
	╪		44		LL4007 MELF/ DO-213AB	1	VD1		
שונ			45		LL4148 miniMELF/ SOD-80	2	VD2		
J de			46		GNL-1206SRC SMD	2	HL 1,HL 2		
Подп. и дата			47		RGB светодиод WS2812B	3	HL3-HL5		
оди.									
Инв. <i>№подл.</i>					АБВГД.З.003.100		Стр. 3		
Z	Изм. Лист № докум. Подпись Дата Копиповал								

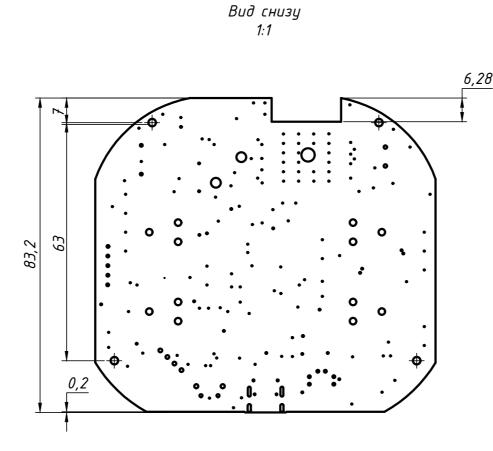
7:	Формат	Зона	Поз.	Оδозначение	Наименование	Кол.	Приме- чание		
Перв. примен.									
lα					Разъёмы и держатели				
рв.			48		PLS-5 (DS1021-1×5)	1	XP1		
Пе			49		PLS-4 (DS1021-1×4)	1	XP2		
			50		Разъём USB Туре-C-31-M-12	1	XS1A		
	┖		51		KEYS54 (KLS5-54T)	4	XT1-XT4		
21		$oxed{oxed}$							
Cnapb. Nº									
nap				Электрорадиоэлементы, устанав.	луваемые при монтаже, смотри				
)				АБВГД.3.003.000 ПЭ					
	┡	\vdash							
	\vdash	H							
	\vdash	\vdash							
В	╀	\vdash							
дата	\vdash	\vdash							
٦	\vdash								
Подп.	\vdash	\vdash							
7/	┝	\vdash							
Взам.инв.№ Инв.№дубл.	\vdash	\vdash							
θ.Ν≌ι	\vdash	\vdash							
9 H	┝	\vdash							
н <i>в.</i> N	\vdash	Н							
JM.UL	\vdash	\vdash							
	上	\vdash							
ıma		\vdash							
, वेव		\vdash							
7. (1		\vdash							
Подп. и дата		\vdash							
	✝				1				
Инв.№подл.							Стр.		
Инв.	АБВГД.3.003.100 Изм.Лист № докум. Подпись Дата								

Перв. примен.









- 1. *Размеры для справок.
- 2. Трассировка печатной платы выполнена в программе Altium Designer 21, файл dAir..... .
- 3. Плату изготовить химическим методом.
- 4. Толщина стеклотекстолита 1,5мм.
- 5. Плату покрыть защитным резистом XV501 TSM фирмы COATES (Великобритания) с двух сторон.
- 6. Материал печатной платы ФС-1-35-1,5.

				АБВГД.З.003.101								
					//	Тит.	Масса	Μαсштαδ				
Изм. Лист	№ докум.	Подпись	Дата									
Разраб.	Фамилия Фамилия			Плата печатная				2:1				
Пров.												
Т.контр.	Фамилия				Лист 1 Листов 1							
Н.контр.	Фамилия			Стеклотекстолит								
Утв.	Фамилия			ΦC – 1–35–1,5								
							φ	004400 12				

